

5月30日(水)

開会挨拶

(運営委員長) 川端 昭

10:25

強誘電体材料(I) (座長) 林 卓 (湘南工科大学)

10:30~12:00

(30-F-1) チタン酸バリウムへの Mn イオンの固溶

(名工大, \*太陽誘電) アンドレイ キリヤノフ, 尾崎 靖尚, 大里 齊, 神津 典之\*, 岸 弘志\*

(30-F-2) チタン酸バリウムセラミックスの強誘電特性の分極電界依存

(静岡理工科大) 小川 敏夫

(30-F-3)  $Ba_6Ti_2Nb_8O_{30}$  強誘電体セラミックスの誘電特性

(福井工大) 吉田 浩二, 金井 兼, 澤崎 正廣, 白藤 純嗣

(30-F-4) 還元雰囲気中で加熱された PLZT に及ぼす電極材料の影響

(富士通研究所) 近藤 正雄, 丸山 研二, 栗原 和明

(30-F-5) モルフォトロピック相境界近傍の高いキュリー温度を有するリラクサ強誘電体固溶体

$Pb(Yb_{1/2}Nb_{1/2})O_3-PbTiO_3$  の結晶育成とその誘電特性

(岐阜大, \*東芝, \*\*関西学院大, \*\*\*名大, \*\*\*\*愛知淑徳大) 安田 直彦, 大和 英弘, 久米 基之,

細野 靖晴\*, 山下 洋八\*, 石野 振一郎\*\*, 寺内 暉\*\*, 岩田 真\*\*\*, 石橋 善弘\*\*\*\*

(30-F-6)  $(Ag, Li)(Nb, Ta)O_3$  セラミックスの強誘電特性

(村田製作所) 坂部 行雄, 竹田 敏和, 小木曾 美文, 和田 信之

薄膜(I)

(座長) 阿部 和秀 ((株)東芝)

13:15~14:45

(30-T-1) 第一原子層制御による  $CeO_2/YSZ/Si(001)$  上の(001)エピタキシャル  $SrTiO_3$  薄膜の MFIS 構造と

その電気特性

(東工大理工) 山田 智明, 石垣 寛和, 脇谷 尚樹, 篠崎 和夫, 水谷 惟恭

(30-T-2) HF+ヒドランジ溶液処理をしたエピタキシャル(100)ZrN/(100)Si 構造上への Ir 薄膜の作製

(北陸先端大) 堀井 貞義, 戸田 猛夫, 堀田 将

(30-T-3)  $(Ba, Sr)TiO_3$  薄膜 MOCVD プロセスにおける酸化反応のその場 FT-IR 分光法による診断

(京大工) 百瀬 俊, 佐原 隆介, 中村 敏浩, 橘 邦英

(30-T-4) 供給酸素が溶液気化 CVD- $(Ba, Sr)TiO_3$  薄膜の成膜反応機構に及ぼす効果

(三菱電機) 山向 幹雄, 川原 孝昭, 大森 達夫, 高田 裕

(30-T-5) Electrical Properties of Mg Doped  $[Ba_{0.5}Sr_{0.5}]TiO_3$  Thin Films

(Yonsei Univ.) K. H. Yoon, J. C. Lee and J. Park

(30-T-6) Effects on Seed Layers on Tunability/Loss of  $Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3$  Capacitors for Voltage Tunable Devices

(Chungnam Nat'l Univ.) Y. A. Jeon and S. G. Yoon

圧電材料(I) (座長) 安達 正利 (富山県立大学)

15:00~16:15

(30-P-1) ハイブリッド焼結で作製した PZT 系セラミックスの諸特性

(富士セラミックス, \*東北大, \*\*防衛大) 高橋 弘文, 加藤 和昭, 袈 進浩\*, 谷 順二\*, 永田 邦裕\*\*

(30-P-2) アーク放電イオンプレーティング法による PZT 厚膜の作製

(スタンレー電気, \*東北工業技術研究所) 安田 喜昭, 赤松 雅洋, 谷 雅直, 吉田 誠, 近藤 健一, 飯島 高志\*

- (30-P-3) スクリーン印刷法によるシリコン基板上への強誘電体厚膜アクチュエータの作製  
(富山県工業技術センター, \*富山県大工) 二口 友昭, 山野 博\*, 安達 正利\*
- (30-P-4) 結晶優先配向性 PZT 薄膜を用いたダイアフラム型アクチュエータの作製  
(産業技術総研, \*日本電産コパル) 飯島 高志, B. P. Zhang, 国井 弘毅\*
- (30-P-5)  $\text{CaBi}_4\text{Ti}_4\text{O}_{15}$  配向セラミックスの圧電特性の温度依存性  
(村田製作所) 小川 弘純, 木村 雅彦, 安藤 陽, 坂部 行雄

**薄膜(Ⅱ) (座長) 宮坂 洋一 (日本電気(株)) 16:30~18:00**

- (30-T-7) エアロゾルデポジション法で作製した PZT 系薄膜の電気・光学特性に対するキャリアガスの影響  
(産業技術総研) 明渡 純, マキシム レベデフ
- (30-T-8) ゴルゲル法による  $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$  薄膜の低温結晶化  
(三菱マテリアル) 牧 一誠, 曾山 信幸, 永峯 薫, 森 暁, 小木 勝実
- (30-T-9) 化学溶液法により作製した反強誘電体  $\text{PbZrO}_3$  薄膜の電気的特性  
(湘南工大, 早大理工\*) 真岩 宏司, 一ノ瀬 昇\*
- (30-T-10) 化学溶液法による Ta 置換  $(\text{Sr},\text{Ba})\text{Nb}_2\text{O}_6$  薄膜の調製と評価  
(名大) 坂本 渉, 堀江 優作, 余語 利信, 平野 眞一
- (30-T-11) Preparation of PZT Thin Film by Sol-gel Hydrothermal Method at Low Temperature  
(Osaka Univ.) Z. Wei, H. Xu, K. Yamashita, M. Noda and M. Okuyama
- (30-T-12) Sol-Gel Derived Ferroelectric  $\text{Pb}(\text{Zr}_{1-x}\text{Ti}_x)\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-B}_2\text{O}_3$  Glass-Ceramic Thin Films at Relatively Low Annealing Temperatures  
(Tokyo Inst. of Tech.) X. Wang and H. Ishiwara

**5月31日(木)**

**薄膜(Ⅲ) (座長) 清水 勝 (姫路工業大学) 9:00~10:15**

- (31-T-13) Mn ドープ  $\text{SrTiO}_3$  薄膜のリーク電流特性  
(太陽誘電) 森戸 健太郎, 鈴木 利昌, 藤本 正之
- (31-T-14) 熱電界放出による新しい疲労特性モデル  
(京大エネルギー) 田尻 雅之, 野澤 博
- (31-T-15) 連続電荷積分法による強誘電体薄膜における圧電緩和の観測  
(静岡大) 符 徳勝, 石川 賢司, 鈴木 久男
- (31-T-16) 変性  $\text{BaTiO}_3$  の強誘電特性と焦電特性  
(東工大, \*名工大, \*\*八戸工大) 掛本 博文, 柿本 健一\*, 藤田 成隆\*\*, 増田 陽一郎\*\*
- (31-T-17) 新圧電性  $\text{Ta}_2\text{O}_5$  薄膜の作成と結晶評価  
(山梨大) 中川 恭彦, 五十嵐 朝美, 土屋 直人

**薄膜(Ⅳ) (座長) 田畑 仁 (大阪大学) 10:30~12:00**

- (31-T-18) MOCVD 法のみによる  $\text{Ir}/\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3/\text{Ir}$  キャパシタの低温作製  
(姫路工大) 藤沢 浩訓, 喜多 賢太郎, 清水 勝, 丹生 博彦

- (31-T-19) 液体供給気化 MOCVD 法による強誘電体  $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$  薄膜の作製  
(奈良先端大) 三宅 雅人, 李 京浩, 河崎 晋, 植田 喜樹, 岡村 総一郎, 塩寄 忠
- (31-T-20) MOCVD 法による電極膜の作製と評価  
(三菱マテリアル) 高山 佳典, 内田 寛人, 小木 勝実
- (31-T-21) MOCVD ソースのリサイクルと有機不純物の影響  
(田中貴金属) 岡本 浩治, 鈴木 弘章, 斎藤 昌幸, 谷内 淳一, 栗田 昌昭, 来田 勝継
- (31-T-22) Growth of Pt, Ru and  $\text{RuO}_2$  Films Obtained by Metal-Organic Chemical Vapour Deposition -  
Optimization of Process Conditions by Thermodynamic Calculations  
(AIXTRON, \*Inst. of Electrical Eng. Slovak, \*\*LTPCM, \*\*\*ESPCI) J. Lindner, P. K. Baumann, M. Schumacher,  
D. Burgess, F. Schienle, H. Juergensen, K. Frohlich\*, D. Machajdik\*, V. Cambel\*, A. Pisch\*\*, P. Doppelt\*\*\*
- (31-T-23) Structural and Electrical Properties of PZT Thin Films Prepared by MOCVD  
Using Ultrasonic Nebulization  
(Keimyung Univ.) C. H. Lee and H. S. Shin

強誘電体材料(Ⅱ) (座長) 坂部 行雄 (村田製作所)

13:15~14:45

- (31-F-7)  $\text{Bi}_{4-x}\text{La}_x\text{Ti}_3\text{O}_{12}$  結晶の作製と評価  
(奈良先端大) 青柳 倫太郎, 駒形 和也, 武田 博明, 岡村 総一郎, 塩寄 忠
- (31-F-8) 強誘電体原料の微粒子化における結晶化度及びコンタミネーションの影響  
(科学技術振興事業団, 東大\*) 宗片 睦夫, 鎌田 修, 白坂 壽和, 樋口 俊郎\*
- (31-F-9) New Lead-free Ferroelectric Ceramics with High and Broad Dielectric Response  
--Synthesis and Dielectric Properties of  $\text{Ba}_{1-x}\text{La}_x\text{Ti}_{1-x}\text{Cr}_x\text{O}_3$  --  
(Waseda Univ.) G. Li, M. Fukunaga, Y. Uesu and K. Kohn
- (31-F-10) The Dielectric Properties and Phase Transition of  $(1-x)\text{Pb}(\text{Yb}_{1/2}\text{Ta}_{1/2})\text{O}_3-x\text{Pb}(\text{Yb}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$   
(KAIST) H. J. Kim, J. H. Lee and W. K. Choo
- (31-F-11) Growth of High Quality  $\text{ReMnO}_3$  (Re:Lanthanide) Single Crystals  
(Hanyang Univ., \*Yamanashi Univ.) N. T. Cho, D. H. Kwon, K. B. Shim, I. Tanaka\* and K. H. Auh
- (31-F-12) Neutron, Electrical, and Magnetic Investigations of  $\text{PbFeO}_3$ - $\text{PbTiO}_3$  System  
(Hoseo Univ., \*KAERI, \*\*Chongju Univ.) J. S. Kim, C. Cheon, H. S. Shim\* and P. W. Jang\*\*

薄膜(V) (座長) 塩寄 忠 (奈良先端大)

15:00~16:15

- (31-T-24) YAG-PLD 法により合成された強誘電体 PZT 薄膜の化学量論性と圧電性  
(名工大, \*東工大, \*\*八戸工大) 柿本 健一, 掛本 博文\*, 藤田 成隆\*\*, 増田 陽一郎\*\*
- (31-T-25) レーザーアブレーション法により作製した PZT 薄膜の微細組織と電気的特性  
(東北工大, \*機械技術研究所) 王 占杰, 前田 龍太郎\*, 一木 正聡\*, 粉川 博之
- (31-T-26) 二段階ポストアニール法により結晶化した  $(\text{Pb},\text{La})(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$  薄膜の観察と電気特性  
(姫路工大, \*富士通研究所) 小舟 正文, 松浦 修武, 松崎 智昭, 澤田 達也,  
嶺重 温, 藤澤 浩訓, 清水 勝, 丹生 博彦, 本田 耕一郎\*

(31-T-27) Liをドーピングした ZnO:X 薄膜の強誘電性と光スイッチング素子への応用

(大阪府立大) 長田 貴弘, 志村 環, 芦田 淳, 藤村 紀文, 伊藤 太一郎

(31-T-28) Influence of Annealing Conditions on the Structure and Ferroelectric Properties of  
PZT Thin Films Prepared by RF-Magnetron Sputtering

(Osaka National Research Institute) R. Thomas, S. Mochizuki, T. Mihara and T. Ishida

特別講演 (座長) 石橋 善弘 (愛知淑徳大学)

16:30~17:30

(31-I-1) 酸化物強誘電体・反強誘電体誕生の頃をふりかえって

(アグネ技術センタ, 村田製作所, 富山県大) 沢口 悦郎, 藤島 啓, 川端 昭

## 6月1日(金) パラレルセッション(202号室)

圧電材料(Ⅱ) (座長) 鶴見 敬章 (東京工業大学)

9:00~10:15

(1-P-6)  $\text{Bi}_3\text{TiNbO}_9\text{-BaBi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$  系ピスマス層状化合物の圧電特性

(TDK) 七尾 勝, 廣瀬 正和, 塚田 岳夫

(1-P-7) 高い機械的品質係数を持つ  $\text{Sr}_{1-x}\text{Ca}_x\text{Bi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$  圧電セラミックス

(足利工大工, 東理大理工) 柴田 和生, 荘司 和男, 坂田 好一郎\*

(1-P-8)  $(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{TiO}_3$  または  $(\text{K}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{TiO}_3$  を主成分とする無鉛圧電セラミックス

(龍谷大理工) 豊池 功司, 今中 洋介, 松尾 嘉浩, 和田 隆博

(1-P-9) チタン酸ナトリウムピスマス-チタン酸バリウム 2 成分系圧電単結晶の育成とその電気的特性

(東芝) 細野 靖晴, 原田 耕一, 山下 洋八

(1-P-10)  $(\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2})\text{TiO}_3\text{-KNbO}_3$  系強誘電体セラミックスの MPB と圧電的性質

(東理大理工) 石井 秀樹, 永田 肇, 竹中 正

圧電材料(Ⅲ) (座長) 増田 陽一郎 (八戸工業大学)

10:30~12:00

(1-P-11) ニオブ酸カリウム強誘電体単結晶の分極処理と圧電特性

(東工大) 和田 智志, 清家 晃, 鶴見 敬章

(1-P-12) ランガサイトにおける自然一方向性をなくす電極材料の実験研究

(三菱マテリアル, 室蘭工大) 王 守琦, 木村 良平, 山口 邦生, 原田 次郎, 宇田 聡, 長谷川 弘治\*

(1-P-13) 圧電体の複素物性定数の測定-矩形板状振動子の伸縮振動-

(名工大工) 橋本 浩之, 前田 雅輝, 鈴木 日/立雄

(1-P-14) 3次元非線形圧電定数の結晶粒径依存性

(防衛大機能材料) 田代 新二郎, 村田 敏郎, 石井 啓介, 五十嵐 秀二

(1-P-15) 水熱合成法による PZT 薄膜を用いた振動子の大幅駆動特性

(東大, \*東工大) 神田 岳文, 小林 豊\*, 黒澤 実\*, 保井 秀彦, 樋口 俊郎

(1-P-16) 積層圧電セラミックトランスデューサのハイパワー特性

(NEC, \*長岡高専) 佐々木 康弘, 高橋 貞行, 山本 満, 越智 篤, 井上 武志, 梅田 幹雄\*

薄膜(VI)

(座長) 徳光 永輔 (東京工業大学)

13:15~14:45

- (1-T-29) 複合アルコキシドから調製したビスマス系層状化合物  $\text{MBi}_4\text{Ti}_4\text{O}_{15}$  (M: アルカリ土類金属) 薄膜の強誘電体特性  
(産業技術総研, \*東工大) 加藤 一実\*, 鈴木 一行, 西澤 かおり, 三木 健
- (1-T-30) エキシマ照射した  $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$  の強誘電体薄膜の作製と評価  
(湘南工大) 林 卓, 戸川 大地
- (1-T-31) ローカルエピタキシャル成長を用いた(1,0,m+1)単配向 Bi 層状強誘電体薄膜の低温合成とその特性評価  
(東工大, \*太陽誘電) 額賀 紀全, 三矢 昌俊, 鈴木 利昌\*, 西 湯二\*, 藤本 正之\*, 舟窪 浩
- (1-T-32) Characterization of Pulse Switching Behavior of Pt/SrBi<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>9</sub>/Pt Capacitors in FeRAM  
(Hyundai Elec. Co.) C. H. Chung, S. H. Oh, B. Yang, Y. M. Kang, S. S. Lee, S. K. Hong, N. S. Kang and H. K. Yoon
- (1-T-33) Potential (Bi,La)<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (BLT) Thin Film Prepared by Low Temperature Process for Ferroelectric Random Access Memory (FeRAM)  
(Hyundai Elec. Co.) W. S. Yang, N. K. Kim, S. J. Yeom, S. Y. Kweon, E. S. Choi and J. S. Roh
- (1-T-34) BLT (Bi<sub>3.3</sub>La<sub>0.8</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub>) Etching in Ar/Cl<sub>2</sub> Mixed High Density Plasma  
(Hyundai Elec. Co.) J. H. Cho, Y. S. Cho, D. S. Kim, J. W. Kim and H. K. Yoon

薄膜(VII)

(座長) 藤村 紀文 (大阪府立大学)

15:00~16:00

- (1-T-35) 極薄シリコン酸化膜挿入による Si-Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> 薄膜界面特性向上効果  
(阪大産研) 六田 英治, 崔 在亨, 堀田 育志, 田畑 仁, 小林 光, 川合 知二
- (1-T-36) MOD 法による Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub>/Bi<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>/Si 構造の作製  
(芝浦工大, 八戸工大\*) 山口 正樹, 長友 隆男, 増田 陽一郎\*
- (1-T-37) (Ba,La)<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> 膜を用いた MFMS 構造の作製と評価  
(東工大) 徳光 永輔, 磯辺 武揚, 木島 健, 石原 宏
- (1-T-38) Effects of Bi Content on Electrical Properties of Pt/SrBi<sub>2</sub>Nb<sub>2</sub>O<sub>9</sub>/Si Ferroelectric Gate Structure  
(Korea Univ., \*KIST) I. H. Choi, H. S. Choi, J. S. Zhao, Y. T. Kim\* and S. I. Kim\*

マイクロ波材料

(座長) 脇野 喜久男 ((株)村田製作所)

16:15~17:15

- (1-M-1) 様々な希土類を添加した Ni-MLCC の微構造と電気特性  
(太陽誘電) 茶園 広一, 岸 弘志
- (1-M-2) Yb<sub>2</sub>Ba(Cu<sub>1-x</sub>M<sub>x</sub>)O<sub>5</sub> (M=Zn and Ni) 固溶体の結晶構造とマイクロ波誘電特性  
(名城大理工, \*名工大) 菅 章紀, 小川 宏隆, 横井 亮太郎, 大里 齊\*
- (1-M-3) Ba<sub>n</sub>La<sub>4</sub>Ti<sub>3+n</sub>O<sub>12+3n</sub> ホモログスシリーズのマイクロ波誘電体特性  
(名工大, \*大研化学) 木内 克将, 大川 隆\*, 岡部 宏城\*, 大里 齊
- (1-M-4) Low Temperature Sintering and Microwave Dielectric Properties of Ca(Li<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>)O<sub>3-δ</sub> Ceramics  
(Kyonggi Univ., \*Yonsei Univ.) P. Liu, E. S. Kim, K. G. Lee, S. G. Kang and K. H. Yoon\*

## パラレルセッション(201号室)

基礎(I) (座長) 山本 孝 (防衛大学校)

9:00~10:15

- (1-B-1)  $\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ - $\text{PbTiO}_3$ 系における相図とラマン散乱(II)  
(名大工, \*岐阜大工, \*\*愛知淑徳大) 岩田 真, 富里 信彰, 折原 宏, 新井 紀男,  
田中 信夫, 大和 英弘\*, 安田 直彦\*, 石橋善弘\*\*
- (1-B-2)  $\text{Bi}_{4-x}\text{La}_x\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ のサイト選択性と構造相転移  
(理研, \*東工大応用セラ, \*\*東工大物質) 長田 実, 多田 大\*, 垣花 真人\*, 渡辺 隆之\*\*, 舟窪 浩\*\*
- (1-B-3) 非晶質  $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ の結晶過程における誘電特性  
(いわき明星大理工, \*明星大理工, \*\*筑波大, \*\*\*釜山大) 高重 正明, 濱崎 真一,  
吉田 龍, 清水 文直, 山口 俊久\*, 小島 誠治\*\*, 張 敏守\*\*\*
- (1-B-4) Phase Transition Studies of  $\text{Pb}(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$  Ceramics  
(Tokyo Inst. of Tech., \*Karpov Inst. of Phys. Chem., \*\*Uppsala Univ., \*\*\*Univ. of Oulu)  
J. Frantti, S. Ivanov\*, S. Eriksson\*\*, J. Lappalainen\*\*\*, V. Lantto\*\*\* and M. Kakihana
- (1-B-5) Dynamical Properties of Relaxor Ferroelectrics  $\text{Pb}(\text{Sc}_{1/2}\text{Ta}_{1/2})\text{O}_3$   
(Univ. of Tsukuba, \*Loffe Tech. Inst.) F. Jiang, J-H Ko, S. Kojima and S. Lushnikov\*

基礎(II) (座長) 上江洲 由晃 (早稲田大学)

10:30~12:00

- (1-B-6) 軟 X 線発光分光法による  $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$  薄膜の電子状態  
(東理大理, \*理研) 樋口 透, 田中 正志, 工藤 和秀, 竹内 智之, 塚本 桓世, 原田 慈久\*, 辛 埴\*
- (1-B-7)  $\text{BaTiO}_3$ における格子ひずみと分極モーメントの関係  
(セイコーエプソン, \*広島大) 宮澤 弘, 名取 栄治, 下田 達也, 岸本 弘樹\*, 石井 史之\*, 小口 多美夫\*
- (1-B-8) 第一原理計算による  $\text{PbTiO}_3$ の弾性的性質と自発分極の研究  
(村田製作所, \*広島大) 西田 邦雄, 葛西 重治, 田中 克彦, 坂部 行雄, 石井 史之\*, 小口 多美夫\*
- (1-B-9) 鉛直および面内圧電応答顕微鏡を用いた強誘電性ドメイン観察  
(防衛大) 新居(沖野) 裕丈, 井田 輝彦, 蛭原 裕士, 山本 孝
- (1-B-10) 走査型非線形誘電率顕微鏡を用いた高次非線形誘電率像計測  
(東北大通研) 長 康雄, 大原 鉦也
- (1-B-11) A サイト置換  $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ の強誘電物性と結晶構造歪み  
(東大生研, \*東理大, \*\*高エネ研) 野口 祐二, 清水 寛之\*, 宮山 勝, 及川 健一\*\*, 神山 崇\*\*

基礎・液晶 (座長) 高重 正明 (いわき明星大学)

13:15~14:45

- (1-E-1) チタン酸バリウムストロンチウムセラミックスの酸素空位の形成と動的挙動  
(信州大工) 深海 龍夫, 阿川 大輔, 番場 教子
- (1-E-2) ニオブ酸カリウム結晶の水溶液中での合成  
(山口大工) 小松 隆一, 安達 謙祐, 池田 攻
- (1-E-3) レーザー加熱帯域溶融法による  $\text{K}_3\text{Li}_{2-x}\text{Nb}_{5+x}\text{O}_{15+2x}$  単結晶ファイバーの分域構造  
(富山県大工) 松倉 誠, 武山 享史, 唐木 智明, 安達 正利

- (1-E-4) 液晶セルにおける配向膜の光学異方性と液晶分子の配向性  
 (\*東理大, \*\*科学技術振興事業団, \*\*\*山口東理大) 清水 忍\*, 舘森 修一\*,  
 古江 広和\*\*, 坂本 美穂子\*, 上原 宏行\*, 幡野 純\*\*\*
- (1-E-5) 反強誘電性液晶の強誘電相における誘電緩和挙動  
 (\*東理大, \*\*山口東理大) 坂本 美穂子\*, 伊藤 めぐみ\*, 舘森 修一\*, 上原 宏行\*, 幡野 純\*\*,\*\*
- (1-E-6) 新規高分子安定化強誘電性液晶: 双安定ドメインの微小化および単安定 V 字特性  
 (\*科学技術振興事業団, \*\*電総研, \*\*\*山口東理大) 古江 広和\*, 横山 浩\*\*,\*, 小林 駿介\*\*\*

圧電材料(IV) (座長) 一ノ瀬 昇 (早稲田大学) 15:00~16:00

- (1-P-17) 液晶ダイレクタの電界挙動が弾性波伝搬に及ぼす影響  
 (阪大, \*防大) 井上 勝, 吉野 勝美, 森武 洋\*, 戸田 耕司\*
- (1-P-18) 強誘電性高分子フッ化ビニリデン/三フッ化エチレン共重合体膜の横波音速の測定  
 (山形大工, \*小林理研) 田實 佳郎, 神原 慎太郎, 前田 英史, 大東 弘二, 伊達 宗宏\*, 深田 栄一\*
- (1-P-19) PZT 圧電セラミックスの高励振駆動時疲労特性と機械特性  
 (石川県工業試験場, \*金沢大学, \*\*防大) 北川 賀津一, 豊田 丈紫, 山名 一男, 北川 和夫\*, 山本 孝\*\*
- (1-P-20) 圧電振動子の過渡状態における振動速度波形と電流波形  
 (長岡高専, \*東工大, \*\*日電) 梅田 幹雄, 中村 健太郎\*, 高橋 貞行\*\*, 上羽 貞行\*

圧電応用(I) (座長) 高橋 貞行 (日本電気(株)) 16:15~17:15

- (1-A-1) タングステンブロンズ型  $\text{PbNb}_2\text{O}_6$  セラミックスの低  $Q_m$  圧電素子への応用  
 (カイジヨー, \*防大) 副島 潤一郎, 永田 邦裕\*
- (1-A-2)  $\text{KNbO}_3$  単結晶圧電体を用いたハーモニクス信号検出用超音波トランスデューサの試作  
 (オリンパス光学, \*電通大) 安達 日出夫, 若林 勝裕, 西尾 真博, 小川 治男, 鎌倉 友男\*
- (1-A-3) Rotary Piezoelectric Actuator - A Novel Design for Dual Stage Actuation Systems in High Density Hard Disk Drives  
 (Nanyang Tech. Univ.) Z. Wang, W. Zhu, O. K. Tan and X. Yao
- (1-A-4) Single Crystal Growth and Characterizations of  $\text{A}_3\text{BC}_3\text{D}_2\text{O}_{14}$ -type Compounds for the Piezoelectric Applications  
 (Hanyang Univ., \*Tohoku Univ.) I. H. Jung, Y. H. Kang, K. B. Shim, A. Yoshikawa\*, T. Fukuda\* and K. H. Auh

チュートリアル (座長) 奥山 雅則 (大阪大学大学院) 17:30~18:30

- (1-TU-1) 圧電性の基礎とデバイス応用  
 (東北大電通研) 長 康雄

6月2日(土)

圧電応用(II) (座長) 竹中 正 (東京理科大学) 9:00~10:15

- (2-A-5) 漏洩ラム波用トランスデューサを用いたドップラー周波数偏移の測定  
 (防衛大) 藤田 剛, 戸田 耕司

- (2-A-6) 両端支持型圧電バイモルフアクチュエータの支持構造の検討  
(\*東芝テック, \*\*山形大) 田沼 千秋\*\*,\*\*, 富川 義朗\*\*
- (2-A-7) 水晶・1 チップ型多機能運動センサの有限要素解析  
(\*長野県工業試験場, \*\*マイクロストーン, \*\*\*山形大) 小板橋 竜雄\*\*,\*\*, 工藤 誠一\*,  
岡田 恵也\*\*, 富川 義朗\*\*\*
- (2-A-8) 低周波平面型圧電振動ジャイロの一構成  
(石巻専修大, \*松下電子) 相沢 宏幸, 菅原 澄夫, 寺田 二郎\*
- (2-A-9) 圧電トランスを用いた無声放電の発光現象  
(千葉工大) 寺西 研二, 鈴木 進, 伊藤 春雄

薄膜(Ⅸ) (座長) 高須 秀視 (ローム(株)) 10:30~12:00

- (2-T-39) 理論的な強誘電体自由表面と強誘電体/絶縁体界面の分極と電子状態の理論  
(九大工) 渡部 行男
- (2-T-40) トレンチ型 MFMS-FET の作製と電気特性  
(日本プレジジョン・サーキット, \*電総研) 坂巻 和男, 右田 真司\*, 熊 四輩\*,  
大田 裕之\*, 酒井 滋樹\*, 垂井 康夫\*
- (2-T-41) インプリント耐性に優れた新スタック型 FeRAM セルの開発  
(松下電子) 長野 能久, 那須 徹, 野間 淳史, 安岡 創, 三木 隆, 中熊 哲治, 森脇 信行, 藤井 英治
- (2-T-42) Deterioration of Device Characteristics of MESFET due to Fatigue  
(Inha Univ., \*Yosu Nat'l Univ.) K. P. Lee, S. J. kang\*, D. H. Chang and Y. S. Yoon
- (2-T-43) Relationships among Coercive Voltage, Memory Window and Electric Distribution in Ferroelectric Gate Structure  
(\*KIST, \*\*Korea Univ.) S. K. Lee\*\*, Y. T. Kim\*, S. I. Kim\* and C. E. Lee\*\*
- (2-T-44) Memory Window of Metal-Ferroelectric-Insulator-Silicon Structures Using Strained (Ba<sub>0.5</sub>Sr<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub> Films  
(Sung Kyun Kwan Univ,) S. Jun, Y. Roh and J. Lee

閉会挨拶

塩寄 忠 (奈良先端大)

12:15